

A METHOD OF FUNCTIONALIZATION OF A GATE ELECTRODE OF A FIELD-EFFECT TRANSISTOR SENSOR

Titolarietà: UNIBA 100%.

Data deposito: EPO 30.12.2017 – pubblicato il 04.07.2018

Eventuali estensioni: PCT 18.12.2017 e Hong Kong 25.06.2018

Stato: Disponibile per accordi di licenza

Ambito territoriale: Internazionale

Area: Chimica

Abstract: L'invenzione consiste in un transistor "electrolyte gated" che integra uno strato di elementi biologici di riconoscimento in grado di rivelare selettivamente il loro ligando di affinità presente ad una concentrazione nel range dello zepto-molare (10^{-12} M).

Inventori: Luisa Torsi, Gerardo Palazzo, Gaetano Scamarcio